



产品特性 FEATURES

- ◆ 硅平面工艺结构 Planar technique
- ◆ 单向负阻性保护 Unidirectional negative resistive protection
- ◆ 低漏电流 Low leakage current

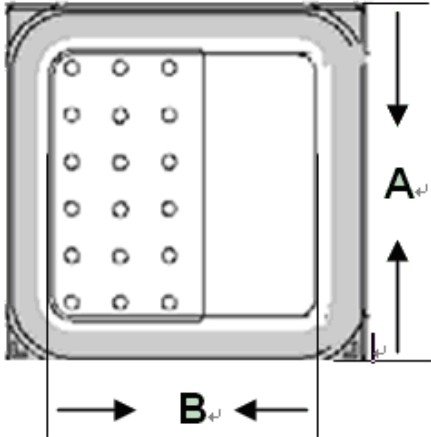
最大额定值 ABSOLUTE RATINGS ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)

项目 Parameter	脉冲峰值电流 Repetitive peak pulse current	绝缘电阻 Insulation Resistance	工作结温 Operation Junction Temperature	存储温度 Storage Temperature
符号 Symbol	I_{PP}	R	T_J	T_{STG}
单位 Unit	A	Ω	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$
额定值 Absolute Ratings	80 (10/1000 μs)	1000M	-40~150	-40~150

芯片电特性 CHIP ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)

参数 Parameter	测试条件 Tests Conditions	最小值 Min.	典型值 Tye.	最大值 Max.	单位 Unit
不动作电压 V_{RM}	$I_{RM}=2\mu\text{A}$	90			V
最高限制电压 V_{BO}	100V/ μs			130	V
通态电压 V_{TM}	$I_T=1\text{A}$			4	V
维持电流 I_H	10A, 10/1000 μs	150			mA
极间电容 C	2V, 1MHz			90	pF

芯片信息 CHIP INFORMATION

圆片尺寸 Wafer Size	Φ4inch（100mm）		
芯片厚度 Chip Thickness	（180-200）μm		
芯片尺寸 Chip Size	A: 1.80mm×1.80mm		
金属 Metal	正面 Front	银 Ag	
	背面 Back	银 Ag	
键合区面积 Bond Area	B: 1.35mm×1.35mm		

附录 (Appendix) : 修订记录 (Revision History)

日期 Date	旧版本 Last Rev.	新版本 New Rev.	修订内容 Description of Changes

